7ДК 5-1.1

ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЧАСТИЦ В ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕМ РАСТВОРЕ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПЛЕНОК In_2O_3 :Sn и SnO_2 :Sb

С.А. Кузнецова*, Т.Д. Малиновская**, В.И. Сачков***

*Томский государственный университет

**Сибирский физико-технический институт

***Томский политехнический университет E-mail: malin@elefot.tsu.ru

Из пленкообразующих растворов комплексных соединений In_1^{3+} , Sn^{4+} а также Sn^{4+} , Sb^{3+} с ацетилацетоном способом "dip-coating" получены тонкие пленки In_2O_3 :Sn и SnO_2 :Sb. Методами UK-, $V\Phi$ -спектроскопии и вискозиметрии установлено строение комплексных частиц в ацетилацетоновом растворе. Изучены оптические, электрофизические свойства и морфология оксидных пленок. Показано влияние строения пленкообразующих растворов комплексных соединений на морфологию и свойства пленок In_2O_3 :Sn и SnO_2 :Sb.

Работы по изучению и внедрению комплексных соединений в технологию тонких оксидных пленок, а также по исследованию процессов, протекающих в пленкообразующих растворах комплексных соединений (ПОРКС), представляют большой практический интерес. Среди перспективных комплексных соединений исследователи выделяют β -дикетонаты [1, 2]. Данная работа посвящена изучению влияния состава и строения ацетилацетонового ПОРКС на морфологию и свойства оксидных пленок In₂O₃:Sn и SnO₂:Sb. Такие пленки обладают электронной проводимостью и характеризуются хорошей прозрачностью при высокой проводимости и находят широкое применение в производстве прозрачных, электропроводящих, теплоотражающих, а также газочувствительных материалов [3].

Экспериментальная часть

Пленки In_2O_3 :Sn и SnO₂:Sb получали вытягиванием из пленкообразующего раствора (метод "*dip-coat*-

ing") индия (III), олова (IV) и сурьмы (III) с ацетилацетоном (Насас). В качестве подложек использовали полированный поликристаллический кварц. Скорость вытягивания составляла 2 мм/с. Термическую обработку образцов, после предварительной сушки, проводили в муфельной печи при температуре 873 К со скоростью нагрева 2 град/мин. Содержание олова и сурьмы в оксидных пленках составляло 13 ат. %.

ПОРКС готовили путем растворения хлоридов In^{3+} и Sn^{4+} (ПОРКС-1), а также Sn^{4+} и Sb^{3+} (ПОРКС-2) в Насас. Концентрация солей $InCl_3$, $SnCl_4$ составляла 0,12 моль/л. Процесс растворения проводили при 333 К в термостате с обратным холодильником до глубокого потемнения растворов. В этих условиях Насас по отношению к катионам ведет себя не только как растворитель, но и как лиганд.

Состав ПОРКС исследовали методами ИК-, УФ-спектроскопии. ИК-спектры снимали на спектрофотометре ИКС-29 в области волновых чисел от 400 до 4200 см $^{-1}$, УФ-спектры — на спектро-

фотометре СФ-20 в области длин волн 220...340 нм относительно Насас. Пленкообразующую способность оценивали по значению вязкости. Вязкость определяли при 298 К на вискозиметре ВПЖ-2 с диаметром капилляров 1,31 и 0,99 мм.

Состав пленок определяли методом рентгено-фазового анализа (РФА) на дифрактометре ДРОН-3М (Си K_{α} -излучение, Ni-фильтр). Пленки представляют собой твердые растворы на основе оксидов индия или олова соответственно, и являются полупроводниками n-типа. Поверхностное сопротивление оценивали с помощью вольтметра ВК7-9; прозрачность пленок — спектрофотометром ИКС-3. Исследование морфологии поверхности и толщины проводили методом трехмерной бесконтактной профилометрии на приборе MICRO MEASURE 3D-station.

Результаты и их обсуждение

С целью изучения составов ПОРКС-1, 2, в работе исследованы ИК-спектры ацетилацетоновых растворов Sn⁴⁺ и Sb³⁺. Зарегистрирован набор основных колебаний характеристических групп (табл. 1). \boldsymbol{B} ацетилацетоновом растворе $Sb^{\scriptscriptstyle 3+}$ отсутствовала диффузионная полоса поглощения -ОН группы енольной формы (3200...2500 см⁻¹) [4], Hacac и присутствовала полоса поглощения (С=О+С=С) хелата при 1481 см⁻¹. В ИК-спектре раствора Sn⁴⁺ обнаружено колебание диффузионной полосы поглощения -ОН группы (2680 см-1) и не обнаружено поглощение (С=О+С=С) групп хелатной структуры. Сгласно ИК-спектрам этих двух растворов в ацетилацетоновом растворе Sn⁴⁺ присутствуют комплексные частицы $[Sn(Hacac)_n]^{4+}$, где Насас связан с ионом олова (IV) кетонной и недиссоциированной енольной формами, а в ацетилацетоновом растворе Sb³⁺ комплексную частицу можно представить как $[Sb(acac)_m(Hacac)_n]^{2+}$. Строение комплексных частиц представлено на рис. 1. Анализ ИК-спектров ПОРКС-1, 2 (табл. 1) указывает на наличие колебания C=O группы (1725...1683 см⁻¹) кетонной формы, C=O групп (1548...1520 см⁻¹) енольной недиссоциированной формы [5, 6]. В ИК-спектре ПОРКС-2, где присутствуют ионы Sn^{4+} совместно с Sb^{3+} , наблюдается полоса колебаний С=О групп енольной формы диссоциированного ацетилацетона хелатной структуры (1450 см $^{-1}$), связанного с ионом Sb $^{3+}$ в комплексной частице. Следовательно, в ПОРКС-2 помимо комплексного иона [Sn(Hacac)_n]⁴⁺ присутствует комплексный ион $[Sb(acac)_m(Hacac)_n]^{2+}$ (рис. 1). ПОРКС-1 представляет собой раствор комплексных частиц $[Sn(Hacac)_n]^{4+}$ и $[In(Hacac)_n]_{3+}$ (рис. 1).

На такое строение комплексных частиц в ПОРКС указывают и их спектры поглощения в УФ-области. Из них видно (рис. 2), что ПОРКС-1 (кривая 1) в УФ-области имеет один широкий максимум поглощения в области длин волн от 270 до 275 нм. Согласно литературным данным [5], эта полоса поглощения вызвана π - π * переходом Насас и характеризует его кето-енольное равновесие, где енольная форма недиссоциированна (рис. 1, a, δ). В спектре поглощения ПОРКС-2 помимо полосы поглощения с максимумом в области длин волн 200...275 нм обнаружена полоса с максимумом на 290 нм, обусловленная π - π * переходом диссоциированной енольной формы ацетилацетона (асас⁻) [7] (рис. 1, c).

Таблица 1. Основные характеристические колебания ПОРКС-1, 2, а также растворов хлоридов Sn⁴+ и Sb³+ в ацетила-

	Раств	оры и их	характері	исти-	
Характеристи-	ческие колебания, см-1				
ческая группа	Sn ⁴⁺		ПОРК	ПОР	
		Sb ³⁺	C-1	KC-2	
(ОН) диффузн. енол	2680	-	2580	2675	
(С=О) кетон	1725	1715	1725	1747,	
(C=O) KeTOH				1683	
(C=O) + (C=C) енол	1540	1534	1548	1520	
(C=O) + (C=C) хелат	_	1481	_	1493	
	1364	1365	1362	1400	
(C-OH) + (CH₃)	1310	1310	1315	1362	
	1254	1257	1256	1251	
	1173	1170	_	1174	
(C-OH) + (C-C)	1018	1019	-	-	
(C OII) 1 (C C)	970	976	967	-	
	933	934	932	925	
π (CH)	807	806	797	792	
Поформац колица ±	666	673	664	-	
Деформац. кольца + (Ме-О)	564	563	-	575	
(IVIE-O)	553	546	549	549	

На практике критерием пленкообразующей способности ПОРКС, а также их устойчивости служит вязкость растворов. Значения кинематической вязкости (η) ПОРКС-1, 2 подтверждают их пленкообразующую способность (η =1,19...1,27 мм²/с) [8]. При этом в стабильной области пленкообразования вязрастворов практически КОСТЬ олинакова $(\eta = 1,230\pm0,004 \text{ мм}^2/\text{c})$, но характер ее изменения во времени отличается. Как видно из рис. 3 в ПОРКС-1 на вторые сутки вязкость незначительно уменьшается и стабилизируется к пятым суткам. В ПОРКС-2 вязкость, проходя через максимум (кривая 2, рис. 3), стабилизируется на 8-е сутки. Так как при

$$\begin{pmatrix} CH_2 \\ H_3 - C \\ O \\ Sn \ (In) \\ a \end{pmatrix}^{4+ \ (3+)} \begin{pmatrix} CH \\ H_3C - C \\ O \\ O \\ O \\ O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C - CH_3 \\ O \\ O \\ O \\ O \end{pmatrix}^{4+ \ (3+)} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ Sb \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ C \\ O \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ C \\ O \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C \\ O \\ C \\ O \\ C \\ O \\ C \end{pmatrix}^{2+} \begin{pmatrix} CH \\ CH_3 - C \\ O \\ C$$

Рис. 1. Структура комплексных частиц в ПОРКС

сравнении ИК-спектров ПОРКС-1, 2, снятых в первый день их приготовления и через 20 дней, никаких изменений не наблюдается, то изменение вязкости может быть связано только с перестройкой растворителя и комплексных частиц [9], а также образованием полимерных ассоциатов -Me-Hacac-Me-Hacac-Me-Hacac-, -Me-Hacac-Me-acac-, где Me= $\mathrm{In^{3+}}$, $\mathrm{Sn^{4+}}$, $\mathrm{Sb^{3+}}$ вследствие способности ацетилацетона выступать в качестве мостикового лиганда [10]. Уменьшение η [9] возможно происходит за счет разрушения структуры растворителя в результате воздействия на Насас электрического поля ионов $\mathrm{Me^{n+}}$, $\mathrm{Cl^{-}}$.

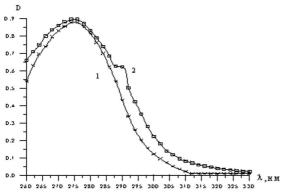


Рис. 2. Поглощение ПОРКС в УФ-области. 1) ПОРКС-1; 2) ПОРКС-2

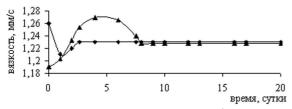
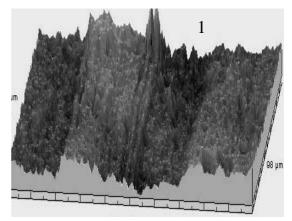


Рис. 3. Изменение вязкости во времени: ▲ — ПОРКС-2, ◆ — ПОРКС-1

Ориентация молекул Насас в поле ионов приводит к росту вязкости. Снижение вязкости в ПОРКС-2 может быть связано с разрушением ассоциатов за счет образования взаимно ориентированных координационно-насыщенных молекул [11] ацетилацетонатов сурьмы хелатного строения с координационным числом 6. Отличие строения комплексных частиц в ПОРКС сказывается на свойствах и морфологии пленок.

В табл. 2 приведены основные физические свойства пленок из которых следует, что поверхностное сопротивление R тонкопленочных покрытий In_2O_3 :Sn меньше, а прозрачность T и толщина d больше соответствующих значений для SnO_2 :Sb. Бо-

лее толстые пленки In_2O_3 :Sn (d=400...600 нм) характеризуются укрупнением размера поверхностных неоднородностей h до 520 нм (табл. 2) и меньшей пористостью (рис. 4). Согласно рентгено-дифрактометрическим данным эти неоднородности состоят из кристаллитов со средним размером 25 \pm 5 нм.



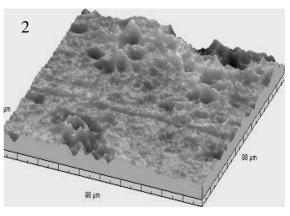


Рис. 4. Морфология поверхности пленок. 1) SnO₂:Sb; 2) In₂O₃:Sn

Пленки SnO_2 : Sb характеризуются большей пористостью и неравномерностью по толщине, рис. 4, (d=120...510 нм) при среднем размере неоднородностей 125 нм и размере кристаллитов 10 ± 5 нм.

Данные факты, вероятно, связаны с различным строением комплексных ионов ПОРКС. Формирование оксидной пленки происходит за счет термической деструкции высушенного ПОРКС на подложке при 873 К. В комплексной частице $[Sb(acac)_n(Hacac)_m]^{2+}$ (ПОРКС-2) в отличие от комплексных частиц $[Sn(Hacac)_n]^{4+}$ и $[In(Hacac)_n]^{3+}$ между Sb^{3+} и диссоциированным ацетилацетоном связь образуется по обменному механизму, пос-

	_	_	
Таблица 2	. Физические	своиства	полученных пленок

Кол-во слоев	In ₂ O ₃ :Sn			SnO ₂ :Sb				
	<i>R</i> , кОм	Т, %	<i>d</i> , нм	<i>h</i> нм	<i>R</i> , кОм	Т, %	<i>d</i> , нм	<i>h</i> нм
1	8090	95	66100	205	90005000	92	4070	42
2	1,51,6	-	90150	-	250190	-	45140	-
3	0,70,8	94	130200	420	9080	87	70140	88
4	0,50,6	-	190270	-	4540	-	80340	-
5	0,40,5	-	260400	_	2010	-	100420	_
6	0,30,4	90	400600	520	1510	82	120150	125

кольку такая связь более прочная и требует большего времени и энергетических затрат для разрушения $[Sb(acac)_n(Hacac)_m]^{2+}$. Возможно, поскольку при формировании оксидного каркаса SnO_2 :Sb затруднено удаление остатков продуктов разложения, что увеличивает пористость пленки. Кроме того, координационно-насыщенный ацетилацетонатный комплекс сурьмы (III) характеризуется высокой летучестью, что может приводить к уменьшению толщины слоя и, соответственно, снижению концентрации носителей заряда за счет снижения общего содержания сурьмы в материале.

Заключение

В результате проведенной работы впервые из пленкообразующих ацетилацетоновых растворов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Сайфулин Р.С. Физико-химия неорганических полимеров и композиционных материалов. М.: Химия, 1990. 290 с.
- Циганова С.И., Дягилева Л.М. Реакционная способность βдикетонатов металлов в реакции термораспада // Успехи химии. — 1996. — Т. 65. — № 4. — С. 334—349.
- Qiag Wei Haixing, Zheng Yohonh Huang. Direct pattering ITO transparent conductire coating // Solar Energy Materials. 2 Solar Gells. -2001. -V. 68. -P. 383-390.
- 4. Гордон А., Форд Р. Спутник химика. М.: Мир, 1976. С. 541.
- Накамото К. ИК-спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений. — М.: Мир, 1991. — С. 287—297.
- Казицина Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР спектроскопии в органической химии. — М.: Высшая школа, 1971. — 241 с.

на основе комплексных соединений индия (III), олова (IV), и сурьмы (III) с ацетилацетоном способом "dip-coating" получены тонкие пленки In_2O_3 :Sn и SnO₂:Sb, с концентрацией легирующего компонента 13 ат. %. Полученные материалы характеризуются прозрачностью не ниже 82 %, толщиной от 40 до 600 нм и сопротивлением 0,3...9000 кОм в зависимости от условий получения. На основании исследований морфологии и физических свойств пленок показано, что они зависят от структуры и свойств ПОРКС. Установлено, что при одинаковых значениях вязкости ПОРКС-1 и ПОРКС-2 и термической обработке пленок, морфология, толщина, а, следовательно, и свойства тонкопленочных материалов In₂O₃:Sn и SnO₂:Sb определяются строением комплексных ионов в исходных пленкообразующих растворах.

- 7. Нейланд О.Е., Страдынь Я.П. и др. Строение и таутомерные превращения дикарбонильных соединений. Рига: Зинатне, 1991. С. 171—174.
- Суйковская Н.В. Химические методы получения тонких прозрачных пленок. Л.: Химия, 1971. 199 с.
- Эрдеи-Груз Т. Явления переноса в водных растворах. М.: Мир, 1976. — 592 с.
- 10. Пешкова В.М., Мельчакова Н.В. β —дикетонаты. М.: Мир, 1976. 592 с.
- Дюков В.В., Кузнецова С.А., Борило Л.П., Козик В.В. Изучение пленкообразующей способности ацетилацетонатов Sn(II), Zr(IV), Hf(IV) // Журнал прикладной химии. 2001. Т. 74, вып. 10. С. 1578—1591.